Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0209U002129

Державний реєстраційний номер: 0106U006767

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-01-2009

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка фізичних принципів і технології створення ІЧ приймачів на основі гетероструктур кадмій-ртуть-телур та діагностичних систем нового покоління.

Початок етапу: 06.2006

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-62-96

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка фізичних принципів і технології створення ІЧ приймачів на основі гетероструктур кадмій-ртуть-телур та діагностичних систем нового покоління.

Назва роботи англійською:

Development of physical principles and technologies of creation IR receiver on basis of heterostructures CdHgTe and diagnostic systems of new generation.

Реферат українською:

Проведено дослідження впливу ультразвукової обробки і гамма-опромінення на еоектрофізичні характеристики гик-фотодіодів і схем прочитування інформації. Встановлено, що після УЗО плівок КРТ спостерігається зміна досліджуваних параметрів залишкового характеру, що акустично стимулює, а саме зменшення рухливості і збільшення електронного вкладу в провідність і також конвертація типа провідності напівпровідника p n. Розроблений Стенд, який в автоматичному або напівавтоматичному режимі дозволяє проводити реєстрацію амплітуди сигналу всіх вічок ROIC, вимір шумів ROIC, вимір нелінійності передавальної характеристики заряд-напруга ROIC, вимір динамічного діапазону ROIC, вимір розкиду порогової напруги ROIC.

Реферат англійською:

Research of influence of ultrasonic treatment and gamma-irradiation on electrophysics descriptions of ik-fotodiodov and charts of read-out of information is conducted. It is set that after UZO of tapes of KRT there is the acoustic stimulated change of the probed parameters of remaining character, namely diminishing of mobility and increase of electronic contribution to conductivity and also converting of type of conductivity of semiconductor of p n. Stand, which in the automatic or semi-automatic mode allows to conduct registration of amplitude of signal of all cells of ROIC, measuring of noises of ROIC, is developed, measuring of non-linearity of transmission description is charge-tension of ROIC, measuring of dynamic range of ROIC, measuring of variation of threshold tensions of ROIC.5635

Індекс УДК: 537.311.322, 537.311.322

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Сизов Федір Федорович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, член-кор.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1 книга, 14 тезисів, 6 статей,5490

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

